

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 55-099762

(43)Date of publication of application : 30.07.1980

(51)Int.Cl.

H01L 27/06

G11C 11/34

H01L 29/78

(21)Application number : 54-007126

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 26.01.1979

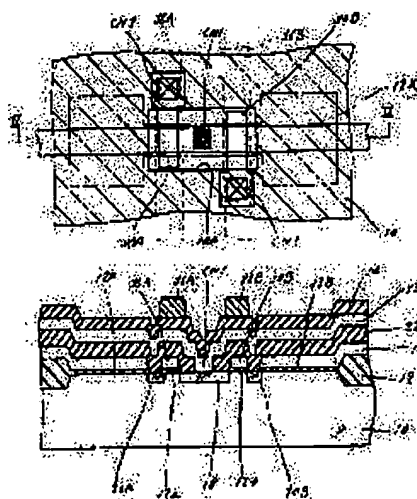
(72)Inventor : KAWAMOTO HIROSHI

(54) SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to get high speed operation without lowering reliability by forming the surface electrode of an information storage capacitor, the gate of an information transfer IGFET and a digit line by using the 1st, 2nd and the 3rd layers poly-silicon.

CONSTITUTION: Field oxide film 12 consisting of SiO₂ is formed on P-type Si semiconductor substrate 10 by selective diffusion, and outline 12X for forming an active region is provided here. Inside this are placed thin silicon oxide films 12A, 12B, 12a, 12b, which have been formed by heat oxidation. The 2nd poly-silicon layers 30A, 30B provided on films 12a and 12b are used only as the gate electrodes of the 1st and 2nd IGFET, and not used as a word line simultaneously. A digit line, to be connected to N⁺-type common source region 18 by means of contact CN1, is formed of the 3rd poly-silicon layer 32. A word line which crosses digit line 32 is formed of the 4th metal layers 36A and 36B.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

⑨ 日本国特許庁 (JP)
⑩ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開
昭55-99762

⑫ Int. Cl.³
H 01 L 27/06
G 11 C 11/34
H 01 L 29/78

識別記号
1 0 1

庁内整理番号
6426-5F
7922-5B
6603-5F

⑬ 公開 昭和55年(1980)7月30日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 半導体記憶装置

⑮ 特 願 昭54-7126
⑯ 出 願 昭54(1979)1月26日
⑰ 発 明 者 川本洋
小平市上水本町1450番地株式会

社日立製作所コンピュータ事業
本部デバイス開発センター内
⑱ 出 願 人 株式会社日立製作所
東京都千代田区丸の内1丁目5
番1号
⑲ 代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 細 書

発明の名称 半導体記憶装置

特許請求の範囲

1. 絶縁ゲート型電界効果トランジスタによって情報蓄積用キャパシタへの情報電荷の出し入れを制御するようにした1トランジスタ形式のセル構造をそなえ、となり合うセルのトランジスタの共通ソース領域に接続したドリフト線を各々のセルのトランジスタのゲートに対応して接続したワード線とはばね交差するように配置して成る半導体記憶装置において、前記キャパシタの駆動電極と、前記トランジスタのゲートと、前記ドリフト線とをいずれもポリシリコンで形成すると共に、前記ワード線を前記ドリフト線に上から重なる金属層で形成したことを特徴とする半導体記憶装置。

発明の詳細な説明

この発明は、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(以下、IGFETという)によって情報蓄積用キャパシタへの情報電荷の出し入れを制御するようにした1トランジスタ形式のセル構造を有す

る半導体記憶装置に関する。

一般に、この種の半導体記憶装置は、その1つのメモリアルセルの等価回路を第1図に示してあるように、情報伝導用のIGFETと、情報蓄積用キャパシタとからなるメモリアルセルをワード線WL及びドリフト線DLの交叉点に対応して多数個マトリクス状に配置することによって構成され、第2図に示すようにワード線電圧 V_w をOVから所定の高電圧にすることによってキャパシタCの情報電荷をIGFETを介してドリフト線DLに読出し、「0」情報に対応したドリフト線電圧 V_{D0} 又は「1」情報に対応したドリフト線電圧 V_{D1} を得るようになっている。そして、このような半導体記憶装置は、第3図及び第4図に示すようにセンスアンプSAに接続される一対のドリフト線DLに対して各ワード線WLがどのように交叉するかとの観点から一交叉点方式のものと二交叉点方式のものとに大別されるのが普通である。すなわち、一交叉点方式のものは第3図に示すように1つのセンスアンプSAに接続される一対のドリフト線DLに対して各ワード線WLがどのように交叉するかとの観点から一交叉点方式のものと二交叉点方式のものとに大別されるのが普通である。すなわち、一交叉点方式のものは第3図に示すように1つのセンスアンプSAに接続される一対のドリフト線DLに対して各ワード線WLがどのように交叉するかとの観点から一交叉点方式のものと二交叉点方式のものとに大別されるのが普通である。

(1)

(2)

ト線Dに対して各ワード線WLが1回しか交差し
ないものであり、二交点方式のものは1つのセ
ンスアンプ8Aに接続される一対のデジタル線D
Lに対して各ワード線WLが2回交差するもので
ある。

上記のようなワード線-デジタル線交差配置は、
当然にセル配置及び周辺回路配置に影響を及ぼす
ものであり、一交点方式の装置は二交点方式のも
のに比べてセル及び周辺回路配置が複雑で、密度
高集積化に適さない欠点がある。このため、最近
の装置は殆ど二交点方式のものになっており、そ
の代表的なセル構造は第5図及び第6図に例示さ
れている。

第5図及び第6図は、従来の二交点方式の半導
体記憶装置のとりあう一対のセルの構造を示す
もので、これらの図において、10はP型シリコ
ンからなる半導体基板、12は基板表面を選択酸
化して形成したSiO₂からなる厚いフィールド
オキサイド膜、18Xはフィールドオキサイド膜
18にアクティブ領域形成用に設けた開口部又は

(3)

及び第3のIGFETのゲートないしワード線と
して作用するポリシリコン層16A、16Bが形
成されている。これらのポリシリコン層16A、
16BはCVD法等により低抵抗の第2層目配線
として形成されるもので、第5図に示すようにポ
リシリコン層14の開口部14Aを横切るように
平面パターンで、しかも面示しないSiO₂など
の層間絶縁膜を介してポリシリコン層14から絶
縁された形で形成されている。

N⁺型領域18、20A、20Bはポリシリコ
ン層14、16A、16Bを形成後、これらをマ
スクとしたいわゆる自己重合方式の拡散及び／又
はイオン打込等の処理で形成されたもので、N⁺型
領域18は第1及び第3のIGFETに共通のソ
ース領域として、またN⁺型領域20A、20B
はそれぞれ第1及び第3のIGFETのドレイン
領域として作用するようになっていく。

ポリシリコン層14、16A、16Bの上には、
SiO₂などの層間絶縁膜22がCVD法等によ
り形成されており、この絶縁膜22の上には、ワ

(5)

その輪郭を示すものである。アクティブ領域形成
用開口部18X内の基板表面には熱酸化法により
形成された薄いシリコンオキサイド膜18A、
18B、18C、18Dが配置されている。シリ
コンオキサイド膜18A、18Bはそれぞれ第1
及び第3の情報蓄積用キャパシタの誘電体とし
て作用するものであり、シリコンオキサイド膜
18C、18Dはそれぞれ第1及び第3のIGFET
のゲート絶縁膜として作用するものである。

シリコンオキサイド膜18、18A、18Bの
上には第5図に示すように開口部14Aを有する
第1層目配線としてのポリシリコン層14がCV
D法等により形成されている。このポリシリ
コン層14は、CVDの過程で又はその後リン等
の不純物が高濃度ドーピングされることによつて低
抵抗化されているもので、シリコンオキサイド膜
18A、18B上に位置する部分がそれぞれ第1
及び第3の情報蓄積用キャパシタの誘電体とし
て作用するようになっている。一方、シリコンオ
キサイド膜18C、18Dの上にはそれぞれ第1

(4)

ード線用ポリシリコン層16A、16Bとほぼ重
交するようにA等からなるデジタル線用金属層
24が形成されている。この金属層24は、第3
層目の配線として蒸着法等により形成されるも
ので、その一部分CNは絶縁膜22に設けたコンタ
クト孔を介して共通ソース領域18にオーミック
接続している。

上記構成の半導体装置は、一交点方式のものに
比べてセル及び周辺回路配置が簡略で、高密度集
積化に好適である利点を有する反面、ワード線が
ポリシリコンで形成されているためその抵抗が大
きく、動作速度が遅い欠点がある。すなわち、通
常ワード線の容量は3〜4pFであり、ワード線
をポリシリコンで形成するとその配線抵抗は10
〜40KΩとなる。このため、かような容量分と
抵抗分とによる信号遅延作用が相対大くなり、
書き込み速度ないし読出速度が低く制限されること
になる。いま第7図を参照して読出時の動作遅延を
例示すると、ワード線に駆動パルスを印加してか
らワード線電圧V_wが定常値に達するまでに約

(6)

80~80 nsec の時間を要する。そして、このような時間遅れの後、情報伝送用 IGFET が十分導通してから "1" 又は "0" に対応したデジタル電圧 V_{D1} 又は V_{D0} が定常値に達する。一方、センスアンプは増幅指令信号が約 10~20 nsec で定常値に達するため情報伝送用 IGFET が十分導通する以前に増幅動作を開始している。しかし、上記のようにワード線ないしデジタル線の電圧立上りが遅いのはいくらかセンスアンプの動作開始が遅くても読出速度は遅くならないものである。

なか、ワード線抵抗を低くして動作速度を高めるためには、第5図及び第6図に示した装置において、ワード線 18A, 18B を A, B 等の金属で形成することも考えられるが、これではその形成手段として蒸着法等を用いることになるため段差部(例えばフィールドオキサイド開口部 18X)で断線が生じやすく、装置の信頼性が低下する欠点がある。

従って、この発明の目的は、信頼性を低下させ

(7)

置した 2 層目ポリシリコン層 80A, 80B をそれぞれ第1及び第3の IGFET のゲート電極としてのみ用いるようにし、ワード線に兼用しないようにしたこと、第2CN+ 拡散ソース領域 18にコンタクト部 CN1 にて接続されるデジタル線を 3 層目のポリシリコン層 88 で形成したこと、第8にデジタル線 88 と直交するワード線を 88 のような 4 層目の金属層 86A, 86B で形成し、これらの金属層 86A, 86B の各一部分 CN2, CN3 を B10₂ などからなる層間絶縁膜 84 の対応するコンタクト孔を介してゲート用ポリシリコン層 80A, 80B にそれぞれオーミック接触させるようにしたことである。なか、上記実施例において、IGFET のゲートを 1 層目ポリシリコンで形成し、キャパシタの表面電極を 3 層目ポリシリコンで形成するようにしてもよい。上記したこの発明の構成によれば、金属層 86A, 86B のシート抵抗を 10²/□程度に低下せうることからワード線の配線抵抗を大幅に低くし、高速動作を行なわせることが可能になる。こ

(8)

ることなく高速動作を可能にした改良された二交点方式の半導体記憶装置を提供することにある。

この発明の実施例による半導体記憶装置は、情報蓄積用キャパシタの表面電極を第1層目のポリシリコンで、情報伝送用 IGFET のゲートを第3層目のポリシリコンで、デジタル線を第4層目のポリシリコンでそれぞれ形成すると共に、ワード線を第4層目の金属層で形成したことを特徴とするものであり、以下、添付図面について詳述する。

第8図及び第9図は、この発明の実施例による 1トランジスタ型セル構造を有する二交点方式の半導体記憶装置を示すもので、特に第8図はとなり合うセルの平面配置を、第9図は第8図に一直線に沿う断面をそれぞれ示している。これらの図において、第5図及び第6図にかけると同様な部分には同様な符号を付してその詳細な説明を省略する。第8図及び第9図に示した装置の特徴とするところは、第1にゲート絶縁膜としてのシリコンオキサイド膜 18a, 18b 上にそれぞれ配

(9)

の点、ポリシリコンのシート抵抗は 10²/□以下に低下させるのが困難であり、この発明によればワード線の配線抵抗を従来の約 1/10 程度に低下させることができる。また、ワード線の配線抵抗の低下は、雑音の影響で生ずる誤動作を防止し、動作の安定性を高める点でも有益である。さらに、この発明の装置では、デジタル線、IGFET のゲート及びキャパシタの表面電極がいずれもポリシリコンで構成され、比較的段差の少ない最上層(第4層)のみが金属配線となっているので、断線事故の発生を最少限にさへすることができ、高い信頼性を確保することができる。なか、この発明の装置は二交点方式のものであるから、一交点方式のものの欠点を伴わないことは明らかであろう。

図面の簡単な説明

第1図は、1トランジスタ型メモリセルの等価回路図、第2図は、第1図の回路の動作を説明するためのタイムチャート、第3図及び第4図はワード線及びデジタル線の配置を示す平面図、第5

1字訂正

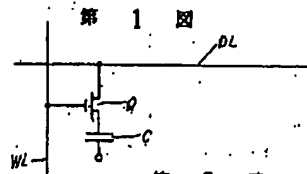
(10)

図は、従来の1トランジスタセル構造の半導体記憶装置の電極配置を示す上面図、第6図は、第5図の装置の同一切線に沿う断面図、第7図は、第5図の装置の動作を説明するためのタイムチャート、第8図は、この発明の一実施例による1トランジスタセル構造の半導体記憶装置の電極配置を示す上面図、第9図は、第8図の装置の同一切線に沿う断面図である。

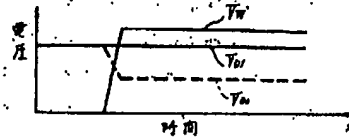
10…半導体基板、12A、12B、12C、12d、12e…シリコンオキサイド膜、14…キャパシタの表面電極としてのポリシリコン層、16A、16B…ゲート・ワード線用ポリシリコン層、18…共通ソース領域、20A、20B…ドレイン領域、22、24…層間絶縁膜、26…デジレット線用金属層、28A、28B…ゲート用ポリシリコン層、28…デジレット線用ポリシリコン層、30A、30B…ワード線用金属層。

代理人 弁理士 藤田利幸

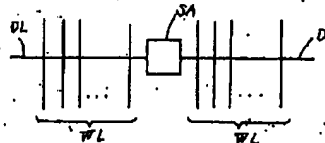
00



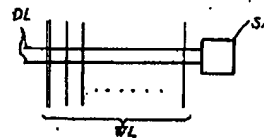
第 2 図



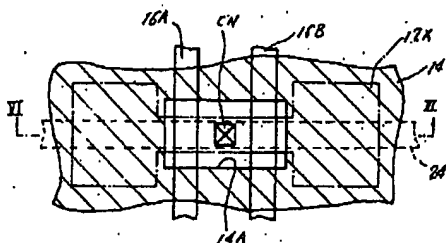
第 3 図



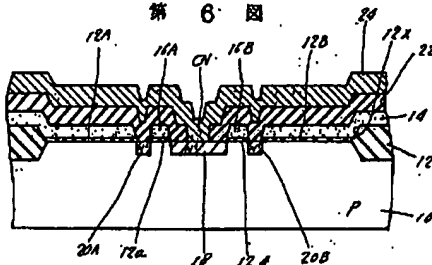
第 4 図



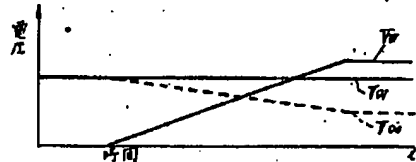
第 5 図



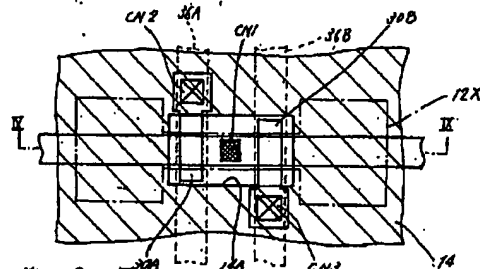
第 6 図



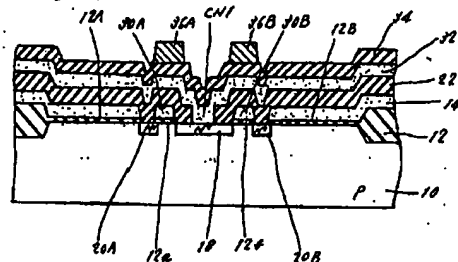
第 7 図



第 8 図



第 9 図



昭 61. 4. 15 発行

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 54 年特許願第 7126 号(特開 昭 55- 99762 号, 昭和 55 年 7 月 30 日 発行 公開特許公報 55- 998 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (3)

Int. Cl. 4	識別記号	庁内整理番号
H01L 27/06	101	6855-5P
G11C 11/34		8522-5B
H01L 29/78		8422-5P

手 続 補 正 書 (自発)

昭和 61 年 1 月 24 日

特許庁長官殿

事件の表示

昭和 54 年 特許願 第 7126 号

発明の名称

半導体記憶装置

方 式
審 査

補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (510) 株式会社 日 立 製 作 所

代 理 人

居 所 〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社日立製作所内

電話 東京 212-1111 (大代表)

氏 名 (6860) 弁護士 小 川 勝 男

補正の対象

明細書の特許請求の範囲の欄

補正の内容

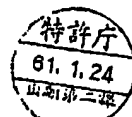
1. 明細書の特許請求の範囲の記載を別紙のとおりに補正する。

別 紙

特許請求の範囲

1. 絶縁ゲート型電界効果トランジスタによって情報蓄積用キャパシタへの情報電荷の出し入れを制御するようにしたメモリセルと、各メモリセルの絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート間を電気的に接続するための接続用配線とを備えてなる二交点方式の半導体記憶装置であって、上記ゲートの電極材料と上記接続用配線の材料とを異ならせたことを特徴とする半導体記憶装置。

代理人 弁護士 小 川 勝 男



(+5) 7-1

BEST AVAILABLE COPY